



**BDY58R: Transistor Npn Silicon Diffused
Mesa 125V 25A**



Descripción

Nombre: TRANSISTOR NPN SILICON DIFFUSED MESA TRANSISTOR NPN DE SILICIO (TECNOLOGÍA MESA) **Referencia:** BDY58R

- Polaridad del transistor: NPN
- Configuración: Single
- Corriente CC máxima de colector: 25A
- Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 125V
- Tensión VCBO colector-base: 160V
- Voltaje VEBO emisor-base: 10V
- Voltaje de saturación colector-emisor: 0.5V
- Dp - Disipación de potencia: 175W
- Producto para ganar Ancho de banda fT: 30 MHz
- Temperatura de trabajo: desde -65°C hasta 200°C

Marca: ASI **Empaque:** TO-3 **Precio por:** Unidad **Ficha Técnica:** [BDY58R](#)

Información del producto

Descripción: TRANSISTOR NPN SILICON DIFFUSED MESA. Marca: ASI. Referencia: BDY58R
El BDY58R es un transistor de unión bipolar (BJT) NPN de alta potencia diseñado para aplicaciones que requieren alta corriente y voltaje. Se utiliza comúnmente en fuentes de alimentación, amplificadores de audio y circuitos de conmutación.

Precio: \$1.850 IVA INCLUIDO

SKU: 9-5-159

Categorías: [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Etiquetas: [0090005000159](#), [9-5-159](#), [ASI](#), [BDY58R](#), [datasheet](#), [pinout](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR NPN SILICON DIFFUSED MESA](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)



BDY57 - BDY58

NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA

U.P. Large Signal Power Amplification
High Collector-Emitter Voltage

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

| Symbol | Rating | Value | Unit |
|------------------|---|-------------|-------|
| V _{CE} | Collector-Emitter Voltage | 125 | V |
| V _{CB} | Collector-Base Voltage | 160 | V |
| V _{EB} | Emitter-Base Voltage | 10 | V |
| I _C | Collector Current | 25 | A |
| I _E | Emitter Current | 25 | A |
| P _{tot} | Power Dissipation @ T _C = 25°C | 175 | Watts |
| T _C | Junction Temperature | 200 | °C |
| T _{stg} | Storage Temperature | -65 to +200 | °C |

THERMAL CHARACTERISTICS

| Symbol | Rating | Value | Unit |
|-----------------|--------------------------------------|-------|------|
| θ _{JA} | Thermal Resistance, Junction to Case | 1 | °C/W |

COMSEMI SEMICONDUCTORS